### Antrieb von Aktoren durch piezoelektrische Dünnschichten

Th.Fabula, 11/93

#### Piezoelektrische Dünnschicht-Materialien

Für die Abschätzung der Leistungsfähigkeit des piezoelektrischen Antriebs werden die Materialien Aluminiumnitrid (AIN), Zinkoxid (ZnO) und PZT-Keramiken (PZT) zugrunde gelegt, die auch als Dünnschichten hergestellt werden können. Da die Materialdaten stark von der Art des Herstellungsprozesses und der Prozeßparameter abhängig sind, fehlen für dünne Schichten meist genaue Materialangaben. Für die folgenden Abschätzungen beziehen sich die Materialdaten, soweit nicht anders angegeben auf Bulk-Material ([Fra88], [Lan82], [Sie81]). Hinzu kommt, daß die Materialeigenschaften schichtdickenabhängig und die abgeschiedenen Schichten innere mechanische Spannungen aufweisen. In der Literatur schwanken die Angaben beispielsweise für ZnO im Vergleich zu den Bulk-Daten bei den Elastizitätsmodulen um ca.  $\pm$  20%, die Schichtspannungen bewegen sich im Bereich bis einige hundert MPa (Zug- und Druckspannung), die Abweichung bei den Dielektrizitätkonstanten (Permittivitäten) beträgt  $\Delta \epsilon_r \approx \pm$  10%, die piezoelektrischen Koeffizienten d<sub>ij</sub> variieren um etwa  $\pm$  15-20%.

#### Piezoelektrische Kopplungsfaktoren

Ein Maß für die Effizienz des piezoelektrischen Antriebs ist der elektromechanische Kopplungsfaktor k. Er erlaubt eine Aussage über die Möglichkeit der Umwandlung von mechanische  $E_{mech}$  in elektrische Energie  $E_{elek}$  eines Materials:  $k^2 \approx E_{mech} / E_{elek}$ . Dieser Kopplungsfaktor ist sowohl von den Materialeigenschaften, als auch von der Geometrie des Wandlers abhängig, so daß sich ein effektiver elektromechanischer Kopplungsfaktor  $k_{eff} = k_{mat} \cdot k_{geo}$  ergibt.

<u>Tabelle 1</u> zeigt einen Vergleich der Materialeigenschaften verschiedener Piezoelektrika und erlaubt eine Abschätzung der theoretisch zu erwartenden materialabhängigen elektromechanischen Kopplungsfaktoren  $k_{mat}$ . Aufgeführt sind die beiden Kopplungsfaktoren  $k_{31}$  bzw.  $k_p$  für einen reinen Transversal- bzw. Planarwandler [VIB]. In Abhängigkeit der unterschiedlichen mechanischen Steifigkeiten (E-Modul:  $E = 1 / S_{11}$ ), der piezo- und dielektrischen Eigenschaften ergeben sich für Aluminiumnitrid, Zinkoxid bzw. PZT-

## Tab.1: Materialeigenschaften mikromechanischer Werkstoffe

Bezugstemperatur: T = 300 K

Material	ę [kg/m³]	S <sup>E</sup> <sub>11</sub> /S <sup>E</sup> <sub>12</sub> [10 <sup>-12</sup> Pa <sup>-1</sup> ]	V	d <sub>31</sub> [10 <sup>-12</sup> C/N]	d <sub>33</sub> [10 <sup>-12</sup> C/N]	$\epsilon^{T}_{11}/\epsilon_{0}$	$\epsilon^{T}_{33}/\epsilon_{0}$	k <sub>31</sub> <sup>mat</sup>	k <sub>p</sub> <sup>mat</sup>
Si	2329	7,68 -2,14	0,28			10	10		
AIN	3260	3,53 -1,01	0,29	-2,00	5,53	9,04	11,4	0,11	0,18
ZnO	5470	7,91 -3,30	0,42	-5,12	12,0	9,26	8,2	0,21	0,40
PZT	7600	15,4 -5,70	0,37	-160	355	1600	1600	0,34	0,61

$$k_p^{mat} = \sqrt{\frac{2}{1-\mathbf{v}}} \cdot k_{31} \approx 1,6..1,9 \cdot k_{31}$$
  $k_{31}^2 = \frac{d_{31}^2}{S_{11}^E \cdot \varepsilon_{33}^T}$ 

Datei: MATAKT, TAB

Keramik (VIBRIT420) unterschiedlich große Kopplungsfaktoren in der Größenordnung von etwa 18%, 40% und 60%. Ein Vergleich der beiden Kopplungsfaktoren  $k_{31}$  und  $k_p$  zeigt, daß der Unterschied bis zu einem Faktor 2, aufgrund des Einflusses der Querkontraktion (Poisson-Zahl), betragen kann. Betrachtet man zusätzlich die Schwankungen der einzelnen Materialdaten bei ZnO wie oben angegeben, so kann die Gesamtabweichung  $(\Delta k_{31}/k_{31})^2 = (\Delta d_{31}/d_{31})^2 + (\Delta S_{11}/2S_{11})^2 + (\Delta \varepsilon_r/2\varepsilon)^2 \approx 25\%$  betragen, d.h. im günstigsten fall  $k_{31} = 0,21 + 25\%$ . Dies führt auf einen erhöhten Kopplungsfaktor von  $k_{mat}^p \approx 50\%$ . Der Einfluß der Aktorgeometrie auf den Kopplungsfaktor (d.h.  $k_{geo}$ ) kann mit Hilfe numerischer Finite-Elemente Berechnungen unter Berücksichtigung der mechanischen und elektrischen Randbedingungen ermittelt werden.

#### Analytische Abschätzungen der erreichbaren Hübe und Kräfte

Bei der analytischen Abschätzung soll von einem einseitig eingespannten Silizium-Biegebalken ausgegangen werden, der von einer piezoelektrischen Dünnschicht bedeckt ist. In der Literatur (siehe [Smi91a], [Smi91b]) ist der Zusammenhang zwischen den externen Parametern (Drehmoment: M, Kraft: F, Druck: P0 und Spannung: P0, siehe P1 und den internen Parametern (Ablenkungswinkel: P1, Auslenkung: P2, Verschiebungsvolumen: P3 und Ladung: P3, siehe P4 aus den linearen piezoelektrischen Zustandsgleichungen abgeleitet.

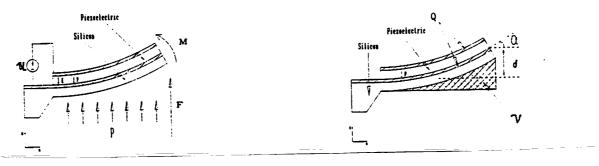


Abb. 1: Externe Parameter M, F, p, U

Abb. 2: Interne Parameter  $\alpha$ ,  $\delta$ , V, Q

Die symmetrische Übertragungsmatrix e<sub>ij</sub> beschreibt den Biegezustand des Balkens bei unterschiedlichen mechanischen und elektrischen Belastungen:

$$\begin{pmatrix} \alpha \\ \delta \\ \nabla \\ Q \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} e_{11} & e_{12} & e_{13} & e_{14} \\ e_{21} & e_{22} & e_{23} & e_{24} \\ e_{31} & e_{32} & e_{33} & e_{34} \\ e_{41} & e_{42} & e_{43} & e_{44} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} M \\ F \\ p \\ U \end{pmatrix}.$$

Die vollständigen Beziehungen lauten:

$$\begin{pmatrix} \alpha \\ \delta \\ v \\ Q \end{pmatrix} = A \begin{pmatrix} \frac{12L}{Kw} & \frac{6L^2}{Kw} & \frac{2L^3}{K} & \frac{6d_{31}BL}{K} \\ \frac{6L^2}{Kw} & \frac{4L^3}{Kw} & \frac{3L^4}{2K} & \frac{3d_{31}BL^2}{K} \\ \frac{2L^3}{K} & \frac{3L^4}{2K} & \frac{3L^5w}{5K} & \frac{d_{31}BL^3w}{K} \\ \frac{6d_{31}BL}{K} & \frac{3d_{31}BL^2}{K} & \frac{d_{31}BL^3w}{K} & \frac{Lw}{Ah_p} \left( \epsilon_{33}^T - \frac{d_{31}^2h_{Si}(s_{11}^{Si}h_p^3 + s_{11}^ph_{Si}^3)}{K} \right) \end{pmatrix}$$

mit den Abkürzungen A, B, K:

$$A = s_{11}^{\text{Si}} s_{11}^{\text{P}} (s_{11}^{\text{P}} h_{\text{Si}} + s_{11}^{\text{Si}} h_{\text{p}})$$

$$K = (s_{11}^{\text{Si}})^{2} (h_{\text{p}})^{4} + 4s_{11}^{\text{Si}} s_{11}^{\text{P}} h_{\text{Si}} (h_{\text{p}})^{3}$$

$$+ 6s_{11}^{\text{Si}} s_{11}^{\text{P}} (h_{\text{Si}})^{2} (h_{\text{p}})^{2} + 4s_{11}^{\text{Si}} s_{11}^{\text{P}} h_{\text{p}} (h_{\text{Si}})^{3}$$

$$+ (s_{11}^{\text{P}})^{2} (h_{\text{Si}})^{4}$$

L, w : Länge, Breite des Biegebalkens [m]

h<sub>si</sub>, h<sub>p</sub>: Substratdicke (hier: Silizium), Piezoschichtdicke [m]

S<sup>Si</sup><sub>11</sub>, S<sup>P</sup><sub>11</sub>: Steifigkeitskoeffizient des Substrats, der Piezoschicht [m²/N]

d<sub>31</sub>: transversaler piezoelektrischer Koeffizient [C/N]

 $\epsilon_{33}$ : Dielektrizitätskonstante in E-Feldrichtung [C/Vm]

Die maximale Auslenkung  $\delta$  beträgt am Balkenende bei Anlegen einer Spannung U an die piezoelektrische Schicht:

$$\delta = e_{24}U = \frac{3d_{31}ABL^2}{K}U$$

Die maximal erreichbare Kraft, die der Bimorph-Balken ausüben kann, läßt sich durch die Federsteifigkeit  $e_{22}^{-1}$  ausdrücken:

$$F = (e_{22})^{-1} \delta = (e_{22})^{-1} e_{24} U$$

Der vollständige Zusammenhang ergibt sich zu:

$$F = \frac{3}{4} \frac{d_{31} wB}{L} U$$

In den obigen Ausdrücken gewichten die Konstanten A [m/Pa³], B [mPa] und K [m⁴/Pa²] die Steifigkeiten mit den entsprechenden Schichtdicken. Der Zusammenhang zwischen der Auslenkung  $\delta$  bzw. ausübbaren Kraft F und der angelegten elektrischen Spannung U ist linear, da die zugrundeliegenden piezoelektrischen Zustandsgleichungen nur Effekte erster Ordnung berücksichtigen. Die Abhängigkeit von der Balkenlänge L ist bei der Auslenkung quadratisch, bei der Kraft umgekehrt proportional. Nachfolgend soll der Einfluß der Wandlergeometrie untersucht werden. Variiert wurden die Balkenlänge L, die Substratdicke  $h_{si}$  und die Piezoschichtdicke  $h_p$ . Die Steifigkeitskoeffizienten vom Silizium-Substrat  $S^{si}_{11}$  und der Piezoschicht  $S^{p}_{11}$ , sowie der transversale piezoelektrische Koeffizient  $d_{31}$  für ZnO wurden der Tabelle 1 entnommen. Tabelle 2 enthält die Proportionalitätskonstanten  $e_{24}$  zwischen der Auslenkung und der angelegten Spannung U. Die Balkenbreite w beträgt bei den Abschätzungen 50  $\mu$ m:

Tabelle 2: Auslenkungs-Konstanten e24 für einen Silizium-Balken mit ZnO-Schicht

h <sub>si</sub>	h <sub>p</sub>	L = 1 mm	2 mm	5 mm
10 <i>μ</i> m	1 <i>µ</i> m	0,113 μm/V	0,452 <i>μ</i> m/V	2,83 <i>µ</i> m/V
	5 <i>µ</i> m	0,045 μm/V	0,181 μm/V	1,131 μm/V
20 <i>µ</i> m	1 <i>µ</i> m	0,032 μm/V	0,129 µm∕V	0,809 μm/V
	5 <i>µ</i> m	0,019 μm/V	0,077 μm/V	0,486 µm/V
30 <i>μ</i> m	1 <i>μ</i> m	0,015 μm/V	0,060 <i>μ</i> m/V	0,377 μm/V
	5 <i>µ</i> m	0,011 μm/V	0,042 μm/V	0,264 μm/V

Ein Vergleich mit FEM-Rechnungen zeigt, daß die analytischen Ergebnisse bei den beiden Extremfällen (fett gedruckt) bis auf etwa 10 % übereinstimmen und damit für erste Ab-

schätzungen herangezogen werden können. In <u>Tabelle 3</u> sind die Proportionalitätskonstanten  $e_{24}/e_{22}$  zwischen der Kraft F und der angelegten Spannung U aufgelistet.

Tabelle 3: Kraft-Konstanten e<sub>24</sub>/e<sub>22</sub> für einen Silizium-Balken mit ZnO-Schicht

h <sub>si</sub>	h <sub>p</sub>	L = 1 mm	2 mm	5 mm
10 <i>μ</i> m	1 <i>μ</i> m	0,243 μN/V	0,121 μN/V	0,049 μN/V
	5 <i>µ</i> m	0,245 μN/V	0,123 μN/V	0,049 μN/V
20 <i>µ</i> m	1 <i>µ</i> m	0,486 μN/V	0,243 μN/V	0,097 μN/V
	5 <i>µ</i> m	0,488 μN/V	0,244 μN/V	0,098 µN/V
30 <i>μ</i> m	1 <i>μ</i> m	0,723 μN/V	0,364 μN/V	0,146 μN/V
	5 <i>μ</i> m	0,731 μN/V	0,366 μΝ/ν	0,146 μN/V

Legt man eine typische Feldstärke von E = 10 V/ $\mu$ m bei ZnO zugrunde [Smi92b], so ergibt sich eine erreichbare Auslenkung von 10 V \* 2,83  $\mu$ m/V = 28,3  $\mu$ m bei den Balkenabmessungen L = 5 mm, h<sub>si</sub> = 10  $\mu$ m und h<sub>p</sub> = 1  $\mu$ m (Variante 1). Die maximal ausübbare Kraft beträgt 50 V \* 0,731  $\mu$ N/V = 36,55  $\mu$ N  $\approx$  0,04 mN für einen Balken mit den Abmessungen L = 1 mm, h<sub>si</sub> = 30  $\mu$ m und h<sub>p</sub> = 5  $\mu$ m (Variante 2).

Je länger der Balken ist, desto größer werden die Auslenkungen, während die ausübbaren Kräfte geringer werden. Wie aus Tabelle 3 ersichtlich, hat die Piezoschichtdicke  $h_p$  kaum einen Einfluß auf die Kräfte, lediglich die Balkendicke  $h_{si}$ . Die Kraftwirkung läßt sich weiter steigern, wenn die Balkenbreite w vergrößert wird:  $F \sim d_{31}$  w  $h_{si}$  / L. Im Gegensatz zu den Kräften geht bei den Auslenkungen die effektive Gesamtdicke des Balkens  $h_{eff} = f(h_{si}, h_p)$  quadratisch im Nenner ein:  $\delta \sim d_{31}$  ( $L/h_{eff}$ )<sup>2</sup>. In der Tabelle 4 sind die beiden Extremfälle (Variante 1: langer Balken und Variante 2: kurzer Balken) analytisch mit den Materialien AlN und PZT (siehe Materialdaten aus Tabelle 1) berechnet worden. Während die Steifigkeiten  $S_{11}$  von AlN, ZnO und PZT nicht stark differieren (Verhältnis: 1,0 / 2,24 / 4,36), unterscheiden sich die piezoelektrischen Koeffizienten  $d_{31}$  sehr stark

(Verhältnis: 1,0 / 2,6 / 80). Die maximalen elektrischen Feldstärken betragen bei AIN 500 V/ $\mu$ m (nach [Ger81], und 170-460 V/ $\mu$ m bei [Fra88]) und bei ZnO 10 V/ $\mu$ m [Smi92b]. Bei Piezokeramiken ist nur der Wert für gesintertes Bulk-Material bekannt, das eine Feldstärke von  $E_{PZT}=0.5$  V/ $\mu$ m im linearen Bereich (Kleinsignalverhalten) und maximal etwa 2-3 V/ $\mu$ m im Sättigungsbereich (Großsignalverhalten) zuläßt [VIB]. Außerdem ist zu beachten, daß im Gegensatz zu Dünnschichten, gesinterte Piezokeramiken eine Depolarisationsspannung aufweisen, die ihrerseits weit unterhalb der eigentlichen Durchbruchfeldstärke liegen kann. Die Angaben der Tabelle 4 beziehen sich daher auf eine Feldstärke von 1 V/ $\mu$ m Schichtdicke.

Tabelle 4: Einfluß des Schichtsystems auf die Auslenkungen und Kräfte

Größe:	AIN	ZnO	PZT	Verhältnis	Dimension
$\delta_{\sf max}$ [ $\mu$ m]	1,79	2,83	53,5	1/1,6/30	Variante 1
F <sub>max</sub> [µN]	0,04	0,05	0,82	1/1,3/21	(U = 1 V)
$\delta_{\sf max}$ [ $\mu$ m]	0,006	0,011	0,22	1/1,8/37	Variante 2
F <sub>max</sub> [μN]	0,55	0,73	12,59	1/1,3/23	(U = 1 V)

Unter Zugrundelegung der gleichen Ansteuerspannung ermöglicht PZT die größten Auslenkungen (ca. 0,05 mm) und Kräfte (ca. 12,59  $\mu$ N). In der 5. Spalte der Tabelle sind die Verhältnisse der bei gleicher Geometrie und Spannung erreichbaren Auslenkungen und Kräfte dargestellt. Beachtet man jedoch die unterschiedlichen maximalen Feldstärken, so differieren sie um mehrere Größenordnungen ( $E_{AIN}/E_{ZnO}/E_{PZT} = 1000/20/1$ ), so daß im Dünnschichtbereich die Verwendung von AIN sehr interessant erscheint.

#### Nichtlineares Großsignalverhalten

Sowohl die analytischen Abschätzungen, als auch die numerischen FEM-Berechnungen gehen von einem linearen piezoelektrischen Zusammenhang zwischen der elektrischen

Feldstärke und den mechanischen Reaktionen des Systems aus. Bei hohen Feldstärken können aber nichtlineare Effekte auftreten, sog. Elektrostriktion:

$$\epsilon_i = d_{ii}E_i + d_{iik}E_iE_k + ...$$

Aus der Literatur [Smi92a] ist bekannt, daß für einen  $Si_3N_4$ -ZnO-Bimorph die Auslenkungen eine sowohl lineare, als auch quadratische Abhängigkeit von der elektrischen Spannung haben können. Empirisch ermittelt ergibt sich eine etwa 2,5-fach größere Abhängigkeit vom quadratischen Spannungsanteil:  $\delta \sim (U + 2,5*U^2)$ .

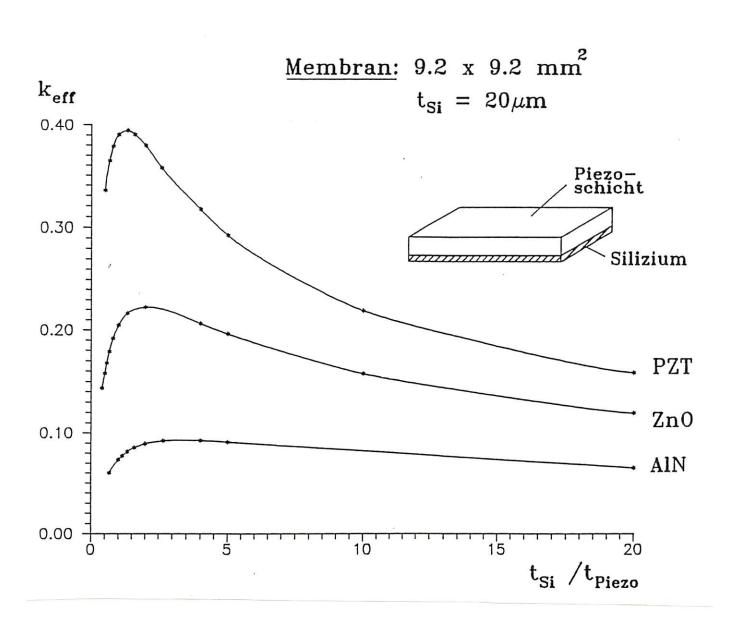
#### Finite-Elemente Berechnungen

Mit Hilfe piezoelektrischer FEM-Berechnungen wurde der Einfluß des Schichtdickenverhältnisses von Siliziumstruktur zu Dünnschicht untersucht [ABV93]. Berechnet wurde für Bimorphmembranen der effektive elektromechanische Kopplungsfaktor k<sub>eff</sub>, der sich durch die Serien- f<sub>s</sub> und Parallelresonanzfrequenz f<sub>p</sub> des piezoelektrischen Ersatzschaltbildes ausdrücken läßt:

$$k_{eff}^2 = \frac{f_p^2 - f_s^2}{f_p^2} \approx 2 \left( \frac{f_p - f_s}{f_p} \right)$$

Ziel der Schichtdickenoptimierung ist ein möglichst hoher elektromechanischer Kopplungsfaktor zwecks maximaler Bauteilhübe und Stellkräfte. Das verwendete dreidimensionale FE-Modell einer Viertelmembran berücksichtigt die anisotropen Materialeigenschaften der ZnO-Dünnschicht und die kristallbedingte (111)-Einspannung der Siliziummembran. Die Abmessungen der Membran betragen 9,2 x 9,2 mm², die Membrandicke beträgt 20  $\mu$ m. Das FE-Modell weist eine durchgehende, unstrukturierte ZnO-Beschichtung auf. Es wurden die Materialeigenschaften von Bulkmaterial verwendet und eine evtl. Verspannung der Zinkoxidschicht nicht berücksichtigt. In Abb. 3 ist der effektive elektromechanische Kopplungsfaktor  $k_{eff}$  für den Grundmode für verschiedene piezoelektrische Schichten in Abhängigkeit des Schichtdickenverhältnisses  $t_{si}/t_{piezo}$  dargestellt. In Tabelle 5 sind die für für veschiedenen Materialien berechneten, jeweils

# Effektiver elektromechanischer Kopplungsfaktor



optimalen Schichtdicken  $t_{piezo}$ , die Resonanzfrequenzen  $f_s$  und  $f_p$ , sowie die daraus abgeleiteten maximalen effektiven Kopplungsfaktoren  $k_{eff}$  aufgelistet.

<u>Tabelle 5:</u> Vergleich der Materialien AlN, ZnO und PZT. Abhängigkeit des effektiven Kopplungsfaktors k<sub>eff</sub> vom Schichtdickenverhältnis:

Material:	t <sub>Si</sub> /t <sub>piezo</sub>	t <sub>opt</sub>	f <sub>s</sub> [kHz]	f <sub>p</sub> [kHz]	k <sub>eff</sub>
AIN	3,3 - 4	5-6 <i>µ</i> m	4,58	4,60	0,09
ZnO	2 - 2,5	9±1 μm	4,05	4,15	0,22
PZT	1,2 - 1,5	$15 \pm 2 \ \mu m$	3,35	3,63	0,39

Im Gegensatz zu den rein materialabhängigen Kopplungsfaktoren  $k_{mat}$  der Tabelle 1 enthalten die effektiven Kopplungsfaktoren  $k_{eff}$  zusätzlich den Geometrieanteil ( $k_{geo}$ ) für eine quadratische Membran. In den Zusammenhang zwischen den Auslenkungen bzw. Kräften und der elektrischen Spannung geht direkt der effektive elektromechansiche Kopplungsfaktoren ein [VIB]:

$$\delta \sim k_{eff} U$$
 und  $F \sim k_{eff} U$ 

Ein weiterer Einfluß auf die Effizienz kann die Art der Ansteuerung des Wandlers haben. Es ist daher sicherzustellen, daß die piezoelektrische Dünnschicht strukturiert wird, um im Bereich von Zugspannungen (bzw. Druckspannungen) auf der Bauteiloberfläche nur Dehnungen (bzw. Kontraktionen) zu erzeugen.

#### Optimierung des piezoelektrischen Antriebs

Das piezoelektrische Wandlungsprinzip eignet sich gut für den Antrieb von Aktoren. Durch die geeignete Wahl der Strukturgeometrie (Balken, Membran, BOSS-Membran), der Schichtdickenverhätnisse und der Elektroden- und Schichtstrukturierung kann der Geometrieanteil des Kopplungsfaktors  $k_{\rm geo}$  vergrößert werden. Die Optimierung der Materialeigenschaften ( $k_{\rm mat}$ ) ist nur in einem durch die Prozeßtechnologie vorgegebenem engen Bereich möglich. Eine Optimierung kann erfolgen:

- durch eine geeignete Wahl des Substrates (Silizium, Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub>) und der piezoelektrischen Schicht (AlN, ZnO, PZT) kann der materialabhängige Anteil k<sub>mat</sub> verbessert werden.
- das Verhältnis der Steifigkeiten des Substrates und der Schicht  $E_{Sub}$  /  $E_{piezo}$  sollte im Rahmen der technologischen Möglichkeiten so groß wie möglich gewählt werden
- durch eine geeignete Strukturierung der piezoelektrischen Schicht und bipolarer elektrischer Anregung kann eine etwa doppelte Auslenkung erreicht werden [ABV93].
- bei Anwendungen, die einen resonanten Betrieb des Aktors zulassen, erhöht sich die dynamische Amplitude A<sub>dynam</sub> um etwa die Schwingungsgüte Q. Diese beträgt bei Biegebalken ca. 500-1000 bei unstrukturierten Membranen etwa 50-100 (bei Normalluftdruck).
- bei hohen Feldstärken, kann aufgrund der Elektrostriktion etwa mit einem zusätzlichen quadratischen Spannungsbeitrag gerechnet werden [Smi92a].
- durch Vergrößerung des Verhältnisses von Wandlerbreite zu Balkenlänge w/L
   kann etwa eine Größenordnung bei der Kraftwirkung erzielt werden. Die
   Auslenkungen sind in erster Näherung unabhängig von der Wandlerbreite.
- durch prozeßtechnisch bedingte Einflüsse kann der piezoelektrische Koeffizient  $d_{31}$  um etwa 20-50% gesteigert werden.

Allerdings ist zu beachten, daß bei praktischen Anwendungen die piezoelektrischen Dünnschichten in der Regel innere Spannungen aufweisen können und auch Hystereseeffekte [Smi92b] auftreten können.

#### Literaturverzeichnis:

- [ABV93]: Abschlußbericht zum BMFT-Verbundprojekt: "Einsatz der Mikromechanik zur Herstellung frequenzanaloger Sensoren", VDI-VDE IT GmbH, Berlin (1993)
- [Fra88]: Franz, J.: Piezoelektrische Sensoren auf Siliziumbasis für akustische Anwendungen, Fortschritt-Berichte VDI, Reihe 10, Nr.: 87, VDI Verlag, Düsseldorf (1988)
- [Ger81]: Gerova, E.V., Ivanov, N.A., Kirov, K.I., Deposition of AlN thin films by magnetron reactive sputtering, Thin Solid Films, 81 (1981) 201-206
- [Lan82]: Landolt-Börnstein, Zahlenwerte und Funktionen aus Naturwissenschaft und Technik, Gruppe III, Band 17a, Berlin, Springer Verlag (1982)
- [Sie81]: VIBRIT Piezokeramik von Siemens, Datenblatt, Stand: Januar 1981, Redwitz
- [Smi91a]: Smits, J.G., Dalke, S.I., Cooney, T.K., The constituent equations of piezoelectric bimorphs, Sensors & Actuators A, 28 (1991) p. 41-61
- [Smi91b]: Smits, J.G., Choi, W., The constituent equations of piezoelectric heterogeneous bimorphs, IEEE Transactions on UFFC, Vol. 38, No. 3 (1991), p.256
- [Smi92a]: Smits, J.G., Choi, W., Very large deflection with quadratic voltage dependence of ZnO on Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub> bimorph, IEEE Transactions on UFFC, Letters, Vol. 39, No. 2 (1992) p. 302
- [Smi92b]: Smits, J.G., Design consideration of a piezoelectric-on-silicon microrobot, Sensors & Actuators A, 35 (1992) p. 129-135
- [VIB]: VIBRIT Piezoceramics from Siemens, Ord.-No.: N-281/5035-101

```
% Datei: AKT-TOM.TEX
% Formeln zu der Aktoren-Abschtzung in LaTeX
\section[Aktoren]
{Analytische Beschreibung mikromechanischer
piezoelektrischen Bimorphstrukturen}
Die symmetrische bertragungsmatrix [$e$] beschreibt den Biegezustand
des Balkens bei unterschiedlichen mechanischen und elektrischen
Belastungen und die verknpft internen mit den externen Parametern:
\begin{eqnarray*}
  \left(
  \begin{array}{c}
  \alpha \\ \delta \\ \upsilon \\ Q
  \end{array} \right) & = &
  \left[
  \begin{array}{llll}
  e_{11} & e_{12} & e_{13} & e_{14} \\
e_{21} & e_{22} & e_{23} & e_{24} \\
  e_{31} & e_{32} & e_{33} & e_{34} \\
  e_{41} & e_{42} & e_{43} & e_{44}
  \end{array}
 \right]
 \left(
 \begin{array}{c}
 M \\ F \\ p \\ U
 \end{array}
\right)
\end{eqnarray*}
Fr die Komponenten $\displaystyle \frac{K}{A} \cdot e {ij}$ der Matrix gilt:
\begin{eqnarray*}
%e & = & A \cdot
\left [
\begin{array}{cccc}
\displaystyle \frac{12L}{Kb} & \displaystyle \frac{6L^{2}}{Kb} &
\displaystyle \frac{2L^{3}}{K} & \frac{6d_{31}BL}{K} \\
\displaystyle \frac{6L^{2}}{Kb} & \displaystyle \frac{4L^{3}}{Kb} &
\displaystyle \frac{3L^{4}}{2K} &
                \displaystyle \frac{3d_{31}BL^{2}}{K}\\
\displaystyle \frac{2L^{3}}{K} & \displaystyle \frac{3L^{4}}{2K} & \\
\displaystyle \frac{3L^{5}b}{5K} & \displaystyle
\frac{3d}{31}BL^{3}b}{K}
\displaystyle \frac{6d_{31}BL}{K}
\displaystyle \displaystyle \frac{3d_{31}BL^{2}}{K} \&
\displaystyle \frac{d_{31}BL^{3}b}{K} \&
\quad \displaystyle \frac{Lb}{Ah_{p}} % \cdot
\left( \epsilon^{K \sigma}_{33} ·
%\frac{
d_{31}^{2} h_{Si} (s^{Si}_{11} h_{p}^{3} + s^{p}_{11} h_{Si}^{3} \ \
\end{array}
\right ]
\end{eqnarray*}
mit den Abkrzungen $ A, B, K $:
\begin{eqnarray*}
```

```
A \& = \& S^{Si}_{11} S^{p}_{11} \setminus, \left( S^{p}_{11} h_{Si} \setminus, + \right),
              S^{Si}_{11} h_{p} \right ) \\
   B \& = \& \frac{h_{Si}}{h_{Si}} + h_{p} }{S^{p} {11} h {Si} },
                   + \sqrt{\ }, S^{Si}_{11} h_{p} \
   & & \nonumber \\

K & = & (S^{Si}_{11})^{2} \, (h_{p})^{4} \, + \, 4S^{Si}_{11}\

S^{p}_{11} h_{Si}(h_{p})^{3} \nonumber \\

& & + \, 6S^{Si}_{11} S^{p}_{11}(h_{Si})^{2}(h_{p})^{2} \, + \,

4S^{Si}_{11} S^{p}_{11} h_{p} (h_{Si})^{3} \nonumber \\
           & + \, (S^{p}_{11})^{2}(h_{Si})^{4}
 \end{eqnarray*}
wobei:
\begin{eqnarray*}
 L, b
                                   & : &
  \mbox{Lnge, Breite des Biegebalkens [m]} \\
 h_{Si},h_{p}
                                   & : &
  \mbox{Substratdicke (hier Silizium), Piezoschichtdicke [m]}
                                                                                   11
 S^{Si}_{11}, S^{p}_{11} &: &
    \mbox{Steifigkeitskoeffizient des Substrats, der Piezoschicht}
  \quad \left [ \frac{m^{2}}{N} \right ] \\
 d_{31} & : & \mbox{transversaler piezoelektrischer Koeffizient}
  \left [ \frac{C}{N} \right ] \\
 \epsilon^{\sigma}_{33} &: &
  \mbox{Dielektrizittskonstante in E-Feldrichtung}
  \left [ \frac{C}{Vm}\right ]
\end{eqnarray*}
```

fatisches Verhalten lewedon, ting

Auslenkungs-Konstanten e24 für einen Silizium-Balken mit ZnO-Schicht

h <sub>si</sub>	h <sub>p</sub>	L = 1 mm	2 mm	5 mm
10 µm	1 µm	0, 113 µm/V	0,452 µm/V	2,83 µm/V
	5 μm	0,045 µm/V	01181 mm/V	1,131 µm/V
20 μm	1 µm	0,032µm/V	0,129 µm/V	0,809 µm/V
	5 μm	0,019 µm/V	0,677 µm/V	0,486 µm/V
30 μm	Λ μm	0,015 µm/V	0,060µm/V	01377 Hm/V
	√ μm	D,MA µm/V	0,042 µm/V	0,264 µm/V

Kraft-Konstanten e24/e22 für einen Silizium-Balken mit ZnO-Schicht

h <sub>si</sub>	h <sub>p</sub>	L = 1  mm	2 mm	5 mm
10 μm	1 µm	0,243 µN/V	0,121 µN/V	01049 4N/V
	ζ μm	0,245 MN/V	01123 HN/V	6,049 µN/V
20 µm	1 μm	0,486 MN/V	0,243 HN/V	0,087-µN/V
	5 μm	0,488 MN/A	0,244 µN/V	0,098-µN/V
30 µm	1 µm	0,723 µN/V	0,364 MN/A	0,146 µN/V
	√ μm	0,731 µN/V	0,366µN/V	0,146 µN/V

Einfluß des Schichtsystems auf die Auslenkungen und Kräfte

	Größe:	AlN	ZnO	PZT	Verhältnis	Dimension
Mat.	$\delta_{\text{max}} [\mu \text{m}]$	17/86	28,3	J34,6	1/1,6/30	
Veglyich	F <sub>max</sub> [μN]	0,38	0,49	8,16	1/1,3/21	U = 10 V
	$\delta_{\rm max}$ [ $\mu$ m]	0,29	0,55	10,89	1/1,9/38	Variante 2
	F <sub>max</sub> [µN]	27;29	36,55	629.5	1/1.3/23	U = 50 V

PtT: Omax = 0,5 mm

Funx = 0,6 m N